

Safety Operation Area Based Design Methodology for Gate Controlled Power Semiconductor Device

湊, 忠玄

<https://doi.org/10.15017/1485067>

出版情報：九州大学, 2014, 博士（工学）, 課程博士
バージョン：
権利関係：全文ファイル公表済

氏 名	湊 忠玄			
論 文 名	Safety Operation Area Based Design Methodology for Gate Controlled Power Semiconductor Device (安全動作領域を確保するゲート制御型電力半導体デバイスの設計法)			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	浅野種正
	副 査	九州大学	教授	庄山正仁
	副 査	九州大学	教授	加藤和利

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本研究は、電力半導体素子の動特性上の安全動作領域を素子の静特性から明示する手法を開発し、それを素子設計に利用して設計期間を大幅に短縮できる設計法を創出したものであり、電気電子工学上の価値ある業績である。